

تأثیر افزودنی کربن اکتیو بر روی ریزساختار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر واکنشی

احمد بیات^{*}، امید میرزا^۱، حمیدرضا بهاروندی^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

۳- دانشیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تهران، ایران

*عهده‌دار مکاتبات: ahmad.bayat@students.semnan.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸)

چکیده: کاربیدبور به دلیل خواصی مانند سختی بالا، مدول الاستیک بالا، چگالی پایین و غیره، بسیار مورد توجه است. با این حال کاربرد آن به علت مشکل در زینتر پذیری و چقلمگی شکست پایین، محدود است. در این تحقیق از روش پرس تک محوری با فشار ۱۴۰ MPa برای فرآیند ساخت پیش فرم‌های متخلخل کاربید بور استفاده گردیده است. مواد اولیه مورد استفاده، پودر B4C با اندازه ۴۳ میکرون، افزودنی کربن اکتیو به میزان ۵٪ و ۱۰٪ درصد وزنی و پودر رزین فولیک به عنوان بایندر و عامل ایجاد تخلخل به میزان ۹٪ وزنی می‌باشد. عملیات رختندهی با مذاب سیلیسیم و تولید سرامیک RBBC در کوره خلا، در دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد انجام شد. در طی فرآیند فلزخوارانی، فاز β -SiC تشکیل شده از سیلیسیم و کربن، موجب افزایش خواص استحکامی نمونه‌ها و همچنین دانسیته حجمی آن‌ها شده است. با افزایش کربن اکتیو، مقدار سیلیسیم باقی‌مانده از ۳۵٪ حجمی به ۱۸٪ حجمی کاهش یافته و در مقابل فاز کاربید سیلیسیم ثانویه از ۱۰٪ حجمی به ۲۱٪ حجمی افزایش یافته است. کاهش سیلیسیم باقی‌مانده و افزایش فاز β -SiC توسط نرم‌افزار آنالیز تصویری مشخص شده است.

واژه‌های کلیدی:

پیش فرم متخلخل کاربیدبور، افزودنی کربن اکتیو، فلزخوارانی و سرامیک RBBC

کاربرد این ماده را در صفحات زرهی سبک از جمله حفاظت هلی کوپترها و ساخت جلیقه‌های ضدگلوله ممکن ساخته است [۱-۲]. مشکل اصلی کاربید بور پایداری شیمیایی بالا است که قابلیت زینترشدن و تراکم‌پذیری آن را محدود می‌کند. علت این امر، پیوندهای کوالانت قوی، پلاستیسیته کم، قابلیت خود نفوذی پایین، مقاومت بالا در برابر لغزش مرzedane و انرژی سطحی پایین کاربید بور خالص است. علاوه بر تراکم‌پذیری ضعیف، چقلمگی شکست پایین کاربید بور (کمتر از ۲/۲ Mpa.m^{1/2}) نیز، کاربرد آن را محدود کرده است [۳-۴].

۱- مقدمه

کاربید بور^۱ ماده‌ای بسیار سخت و مناسب برای بسیاری از کاربردهای دما بالا است و خواصی نظیر سختی بالا (GPa)، دانسیته پایین ($2/52 \text{ g.cm}^{-3}$)، نقطه ذوب بالا (۲۴۴۷ °C)، مدول الاستیک خوب (GPa)، پایداری شیمیایی مناسب، قابلیت جذب نوترون و غیره را دارد که خواص استراتژیک کاربید بور در خصوص مسئله جذب نوترون موجب کاربردهای آن در تأسیسات هسته‌ای شده و همچنین

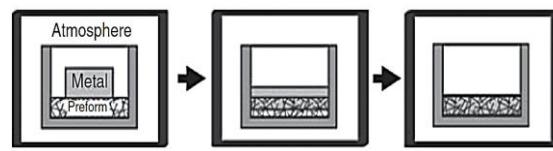
دیگر باعث افزایش چرمگی شکست می‌شود [۱۱]. در مطالعه انجام شده دیگر تأثیر افزودنی آلومینیوم بر روی ریزساختار سرامیک‌های RBBC بررسی شده است که با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش مقدار آلومینیوم، حلالیت کاربید بور در سیلیسیم مذاب افزایش یافته است [۱۲]. برخی از سرامیک‌هایی که تاکنون به روش رخنه‌دهی تولید شده‌اند، عبارت‌اند از: رخنه‌دهی آلومینیوم درون پیش‌فرم‌های SiC-B₄C [۱۳]، رخنه‌دهی آلومینیوم درون پیش‌فرم‌های اکسیدی به همراه افزودنی لیتیم [۱۴-۱۵]، رخنه‌دهی آلیاژهای مس در SiC تحت خلا [۱۶] و رخنه‌دهی سیلیسیم درون پیش‌فرم‌های B₄C و SiC [۱۷]. در زمینه فرآیند پیوندی واکنشی کاربید بور (RBBC) تحقیقات متعددی از جمله بررسی تأثیر آلومینیوم بر روی ریزساختار [۱۳]، تأثیر مقدار سیلیسیم بر روی خواص [۱۳] و بررسی خواص استاتیکی و دینامیکی قطعات تولیدی به این روش [۱۳] صورت گرفته است و در این پژوهش، برای اولین بار تأثیر افزودنی کربن اکتیو بر روی ریزساختار سرامیک RBBC بررسی شده است. به منظور بررسی ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نرم‌افزار تصویری کلمکس^۵ استفاده شده است.

۲- مواد و روش انجام آزمایش

۲-۱- مواد اولیه

به منظور بررسی تأثیر افزودنی کربن اکتیو بر روی ریزساختار سرامیک B₄C-SiC، طبق جدول ۱، از پودر کاربید بور (خلوص ۰/۹۹/۷٪)، وزنی رزین فنولیک به عنوان بایندر و عامل ایجاد تخلخل و کربن اکتیو با اندازه $D_{50} = ۲۲/۹۶ \mu\text{m}$ در مقادیر ۵ و ۱۰ درصد وزنی، به عنوان منبع کربن جهت واکنش با سیلیسیم مذاب و تشکیل کاربید سیلیسیم ثانویه استفاده شده است. چراکه کربن از نوع گرافیت به دلیل ترشوندگی پایین توسط مذاب، خیلی مناسب فرآیند رخنه‌دهی نمی‌باشد [۱۸]. محلول اتانول با خلوص ۰/۹۹/۷٪ نیز به عنوان محیط آسیاب ترجهت ترکیب کردن پودرهای کار گرفته شد. شکل ۲ توزیع اندازه ذرات کاربید بور را نشان می‌دهد که به ترتیب دارای $D_{10} = ۶/۲۳ \mu\text{m}$ ،

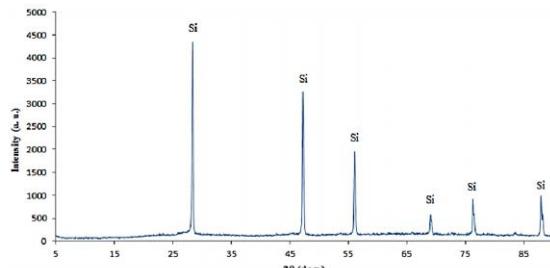
رسیدن به دانسیته نسبی بسیار بالا معمولاً با روش‌های پرهزینه پرس‌گرم در دماهای بالاتر از ۲۳۰۰ °C امکان‌پذیر است، ولی در یک قطعه کاملاً متراکم B₄C، حساسیت به شکست ترد همچنان باقی است [۵]. لذا برای حل این مشکلات و تولید اقتصادی قطعات کاربید بور بهتر است که از روش اتصال زینتر واکنشی^۶ استفاده گردد که نسبت به روش‌های مرسوم کم‌هزینه‌تر و دارای خواص بسیار مطلوبی است [۶]. تکنولوژی زینتر واکنشی اولین بار در سال ۱۹۵۰ با رخنه‌دهی سیلیسیم مذاب در پیش‌فرم کاربید سیلیسیم انجام شد [۷]. یکی از پرکاربردترین روش‌های رخنه‌دهی، فلزخوارانی تحت نیروی گرانش در فشار خلا می‌باشد که این فرآیند به صورت شماتیک در شکل ۱ نشان داده شده است [۸]. کلیات فرآیند رخنه‌دهی شامل جریان یافتن یک سیال به درون فضای خالی یک ساختار متخلخل بوده که در اثر واکنش فلز مذاب با سطح ذرات پیش‌فرم و ایجاد یک شبکه مستحکم، سرامیک زینتر واکنشی تشکیل می‌گردد [۹].



شکل (۱): شماتیک فرآیند رخنه‌دهی تحت نیروی گرانش در فشار خلا [۸].

جنبهای مختلفی از فرآیند پیوندی واکنشی کاربید بور در چندین تحقیق مطالعه شده است. هاین و همکارانش^۳ خواص استاتیکی و دینامیکی با نرخ کرنش $= 10^3 \text{ s}^{-1}$ بر ثانیه را در سرامیک RBBC را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق مشاهده شد که خواص استاتیکی سرامیک‌ها مانند سختی، مدول الاستیک و چرمگی شکست (K_{IC}) به سیلیسیم باقی‌مانده وابسته است، در حالی که خواص دینامیکی مانند استحکام دینامیکی و چرمگی شکست دینامیکی (K_{Id}) نسبت به سیلیسیم باقی‌مانده حساس نیستند [۱۰]. چیلار و همکارانش^۴ نشان داده‌اند که افزایش سیلیسیم باقی‌مانده در ساختار کامپوزیت RBBC باعث کاهش سختی، استحکام خمشی و مدول یانگ شده و از طرف

برای انجام رخنه‌دهی درون تخلخل‌های پیش فرم متخلخل کاربید بور و عملیات فلزخوارانی از کلوخه سیلیسیمی با خلوص ۹۹/۹ درصد استفاده شد. شکل ۵ الگوی پراش اشعه ایکس سیلیسیم را نشان می‌دهد.



شکل (۵): الگوی پراش اشعه ایکس از کلوخه سیلیسیمی مورد استفاده.

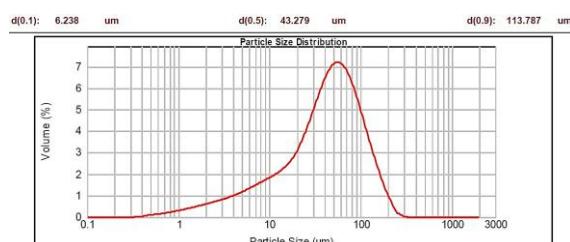
جدول (۱): ترکیبات اولیه و مشخصات سرامیک‌های RBBC تولید شده.

نمونه	رنگ رنگیک (Wt. %)	کربن اکتیو (Wt. %)	کاربیدبور (Wt. %)	فشار پرس (MPa)	دمای فلزخوارانی (°C)
RB-1	۹	۰	۹۱	۱۴۰	۱۶۰۰
RB-2	۹	۵	۸۶	۱۴۰	۱۶۰۰
RB-3	۹	۱۰	۸۱	۱۴۰	۱۶۰۰

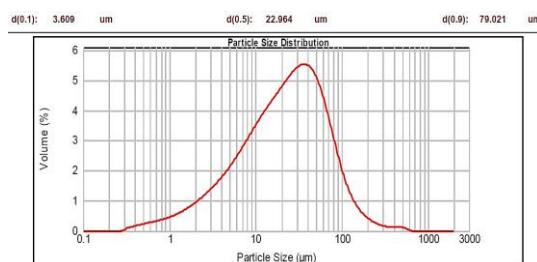
۲-۲- روش انجام تحقیق

جهت تولید پیش فرم کاربید بور، ابتدا مخلوط پودرهای نسبت وزنی پودر به گلوله ۱ به ۱۰ در آسیاب سیارهای با محیط‌تر ریخته شد و به مدت ۲ ساعت با سرعت ۱۷۰ rpm عملیات مخلوط کردن پودرها صورت گرفت. گلوله‌های مورد استفاده از جنس کاربید تنگستن و محفظه آسیاب سیارهای جهت عملیات ترکیب کردن پودرهای اولیه نیز از جنس فولاد زنگ نزن بودند. سپس برای خارج کردن اتانول از پودر ترکیب شده که به عنوان ماده‌تر کننده آسیاب استفاده شده بود، مخلوط پودرها درون آون با دمای ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴-۶ ساعت قرار گرفته و به منظور جلوگیری از آگلومراسیون پودرها، پس از آسیاب دستی در هاون، از الک با مش ۶۵ عبور داده شدند. بعداز آن، عملیات شکل‌دهی پودرهای آماده شده با استفاده از پرس هیدرولیک تک محوره در قالب فولادی تحت فشار ۱۴۰ MPa صورت گرفت. نمونه‌های مستطیلی تولیدی دارای

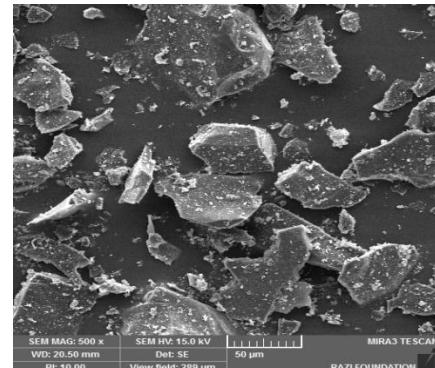
$D_{50} = ۴۳/۲۷ \mu\text{m}$ و $D_{90} = ۱۱۳/۷۸ \mu\text{m}$ می‌باشد. شکل ۳ نیز توزیع اندازه ذره کربن اکتیو را نشان می‌دهد که توزیع ذرات کاربید بور و کربن اکتیو توسط دستگاه آنالیز PSA مدل Masterisizer 2000 اندازه‌گیری شده‌اند. سطح ویژه پودرهای کاربید بور و کربن اکتیو به ترتیب $۰/۸۶۵ \text{ m}^2/\text{g}$ و $۰/۷۶۴ \text{ m}^2/\text{g}$ می‌باشند. تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از مورفولوژی ذرات پودر کاربید بور استفاده شده با اندازه $۴۳ \mu\text{m}$ و بزرگنمایی $۵۰۰\times$ در شکل ۴ آورده شده است. مورفولوژی دندانه‌دار و گوشیدار بودن ذرات به خوبی قابل مشاهده است.



شکل (۲): پودر کاربیدبور پس از آنالیز PSA با اندازه ذره $D_{50}=۴۳ \mu\text{m}$



شکل (۳): پودر کربن اکتیو پس از آنالیز PSA با اندازه ذره $D_{50}=۲۲ \mu\text{m}$



شکل (۴): تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) از پودر اولیه کاربید بور با اندازه $D_{50}=۴۳ \mu\text{m}$

بهره برده شد. تعیین استحکام خمشی (مدول گسیختگی) قطعات توسط آزمون خمش سه نقطه‌ای و بر اساس استاندارد ASTM C1161-02c صورت گرفت. برای این منظور از دستگاه آزمون خمش با نرخ بارگذاری 0.5 mm/min استفاده شد. میزان دانسیته و تخلخل نمونه‌ها با استفاده از روش ارشمیدس و بر اساس استاندارد ASTM B311 مورد بررسی قرار گرفت.

۳ - نتایج و بحث

۱-۳- آنالیز پراش اشعه ایکس

برای مشخص کردن فازهای موجود در کامپوزیت RBBC از آزمایش پراش اشعه ایکس استفاده شده است. شکل ۶ طیف XRD مربوط به کامپوزیت RBBC را نشان می‌دهد که این کامپوزیت شامل فازهای B_4C اولیه، SiC ثانویه، Si باقیمانده و فاز کاربیدی جدید $\text{B}_{12}(\text{C},\text{Si},\text{B})_3$ می‌باشد. واکنش‌های احتمالی میان سیلیسیم، کربن، کاربیدبور در دمای فلزخورانی (1600°C) در واکنش‌های (۱) و (۲) آورده شده است [۱۹-۲۰]:

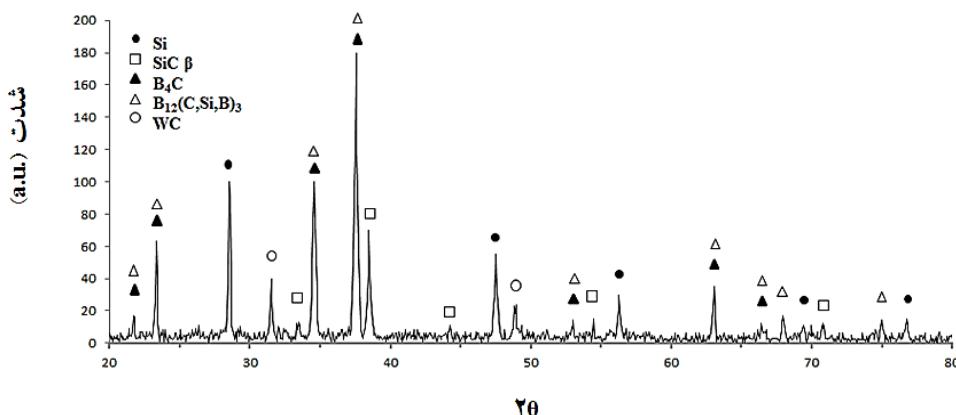


با توجه به نفوذ اتم‌های بور و کربن بر اساس واکنش انحلال-رسوب، تشکیل فاز کاربید سه‌تایی $\text{B}_{12}(\text{C},\text{Si},\text{B})_3$ طبق رابطه (۱) صورت می‌گیرد که در الگوی پراش اشعه ایکس قابل مشاهده است. طبق رابطه (۲) نیز، فاز $\beta\text{-SiC}$ در اثر واکنش بین سیلیسیم و کربن آزاد موجود به وجود آمده است. مقادیر WC موجود نیز حدس زده می‌شود که از گلوله‌های موجود در آسیاب سیاره‌ای در حین مخلوط کردن پودرها وارد شده باشد.

بعاد $32 \times 16 \times 4/5$ میلی‌متر بودند. پس از عملیات شکل دهنده، به منظور حذف مواد فرار و تشکیل پیش‌فرم‌های متخلخل، قطعات با نرخ $2^\circ\text{C}/\text{min}$ در 600°C کوره با اتمسفر آرگون حرارت داده شدند و جهت اطمینان یافتن از تکمیل فرآیند پیرویز، ۱ ساعت در این دما نگهداشته شدند. در نهایت عملیات فلزخورانی به منظور تولید کامپوزیت RBBC صورت گرفت. در این مرحله یک قطعه سیلیسیم خالص بر روی سطح پیش‌فرم تهیه شده به روش پرس قرار داده شد و پس از قرارگیری در کوره با اتمسفر خلا 10^{-5} torr در 3°C تا دمای 1600°C با نرخ $10^\circ\text{C}/\text{min}$ حرارت داده شد و سپس جهت تکمیل فرآیند ذوب شدن سیلیسیم داخل پیش‌فرم و انجام واکنش‌های موردنیاز، به مدت یک ساعت در دمای فلزخورانی نگهداشته شدند. سیلیسیم مذاب رخنه داده شده داخل پیش‌فرم کاربید بور حفرات را پر می‌کند و با ذرات کاربید بور یا کربن آزاد واکنش می‌دهد و کامپوزیت RBBC به دست می‌آید.

۲-۳- ارزیابی‌های انجام شده

به منظور انجام آنالیز فازی، از دستگاه پراش اشعه ایکس مدل D8 Bruker با استفاده از پرتوی $\text{CuK}\alpha$ و فیلتر نیکل با ولتاژ 40 KV استفاده شد. برای بررسی ریزاساختار نمونه‌ها، پس از سنباده‌زنی و پولیش به وسیله خمیر الماسه‌های μm ، $6 \mu\text{m}$ و $3 \mu\text{m}$ ، سطح نمونه‌های فلزخورانی شده با محلولی حاوی یک درصد وزنی KOH و به مدت ۹۰ ثانیه اج شده و به وسیله دستگاه SEM با ولتاژ اعمالی $15-30 \text{ KV}$ مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نقطه‌ای، خطی نمونه‌ها نیز به وسیله EDAX انجام شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی توسط دستگاه‌های SEM و FESEM به ترتیب با مدل‌های Mira 3-XMU و VEGA\TESCAN-LMU گرفته شده است. جهت بررسی درصد فازهای تشکیل شده از نرم‌افزار Clemex CIR, Version 4.0 آنالیز تصویری کلمکس (Clemex CIR, Version 4.0) انجام شد.



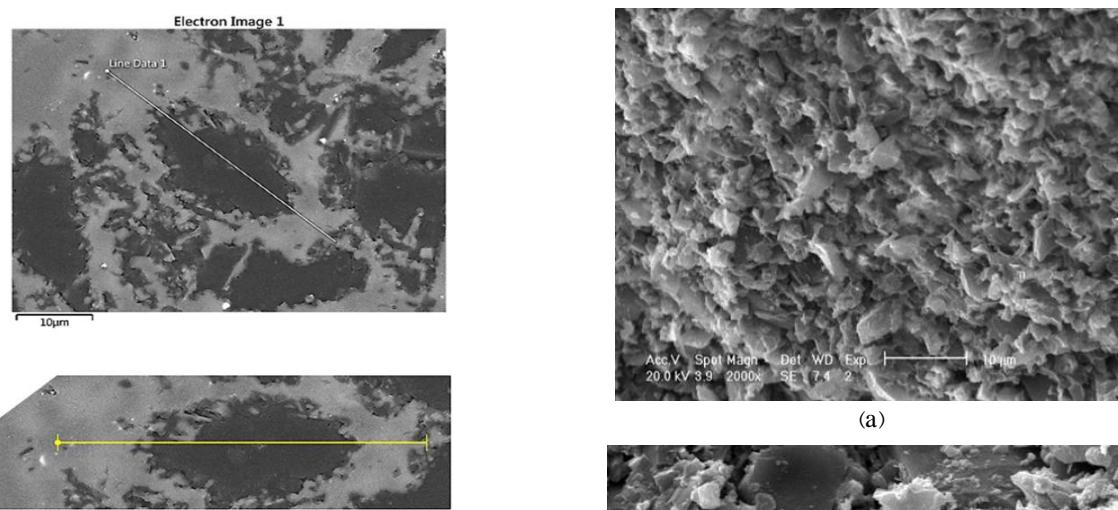
شکل (۶): آنالیز پراش اشعه ایکس برای کامپوزیت RBBC

عملیات پیرویز نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود با حذف پلیمرها از ساختار، بدنه متخلخل ایجاد شده است و به نظر می‌رسد که حفرات و تخلخل‌های ایجاد شده نیز از نوع تخلخل‌های باز بوده است. در شکل ۸ تصویر ریزساختاری از سطح پولیش شده کامپوزیت ۲-RB به همراه آنالیز EDS ناچالصی تنگستنی، نشان داده شده است. از آنالیز EDS به منظور بررسی نیمه کمی عناصر و شناسایی فازها در ساختار استفاده شده است. با توجه به آنالیز گرفته شده در شکل‌های ۹ و ۱۰، دانه‌های B_4C با رنگ مشکی و فاز کاربید سیلیسیم ثانویه (β -SiC) اصطلاحاً به صورت هاله‌ی ابری خاکستری^۷ تیره‌رنگ در زمینه سیلیسیمی با رنگ خاکستری روشن، تشکیل و پراکنده شده است. تشکیل فاز β -SiC به صورت هاله ابری توسط ژانگ و همکارانش نیز گرفته شده است [۲۲]. همان‌طور که در تصویر ۸ مشاهده می‌شود، اطراف دانه‌های کاربیدبور را فازی جداگانه به صورت هاله فراگرفته است که با توجه به آنالیز EDS گرفته شده، شامل سه عنصر بور، کربن و سیلیسیم می‌باشد که طبق تحقیقات پژوهشگران، هاله احاطه شده اطراف دانه‌های B_4C همان فاز کاربید سه‌تایی یا کاربیدبور ثانویه می‌باشد [۲۳-۲۴]. همان‌طور که در شکل ۹ مشخص است، آنالیز خطی گرفته شده از منطقه کاربید سیلیسیم ثانویه شروع شده و پس از عبور از منطقه سیلیسیم باقی‌مانده وارد منطقه کاربید سه‌تایی و کاربیدبور می‌شود.

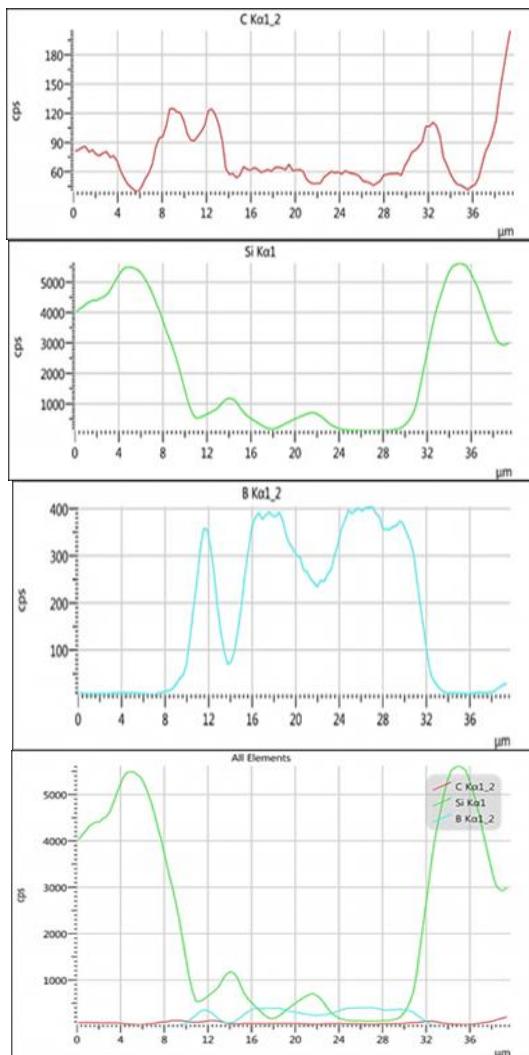
۲-۳- بررسی ساختار میکروسکوپی

به منظور تولید سرامیک‌های زینتر واکنشی، زمانی که پودرهای خام توسط عملیات پرس شکل داده شدند، پیش از فرآیند فلزخوارانی بایستی کاملاً تمامی مواد افزوده شده به آن خارج گردند. اگر ماده پلیمری همچنان در مرحله رخنه‌دهی در بدنه وجود داشته باشد، حجم بالایی از گاز با یک الگوی نامتعارف و غیرقابل کنترل آزاد خواهد شد که منجر به ایجاد ترک در نمونه می‌گردد. مقدار و نرخ گرمای موردنیاز برای تبخیر و واکنش‌های لازم برای تجزیه بایندر، از اهمیت بالایی برخوردار است. با در نظر گرفتن ملاحظات انتقال جرم (حجم مواد آزادشده) و حرارت، این دو فرآیند با ایجاد تنفس پسماند در قطعه همراه هستند که ناشی از گردابیان‌های دمایی یا فشاری مایع یا گاز در بدنه می‌باشد [۲۱]. این تنفس‌ها بایستی کنترل شوند تا از ایجاد ترک و پیچ خوردگی در قطعه جلوگیری به عمل آید.

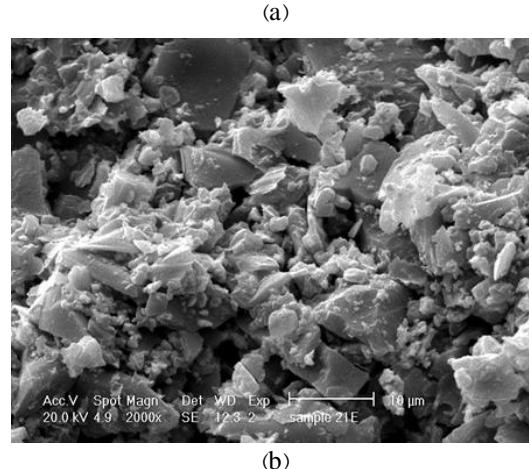
تصاویر ساختار میکروسکوپی پیش فرم کاربید بور قبل و بعد از فرآیند پیرویز در بزرگنمایی $\times 2000$ ، در شکل ۷ نمایش داده شده‌اند. هدف از تهیه این تصاویر بررسی و مشاهده ساختار میکروسکوپی و اطمینان یافتن از حذف پلیمرها از ساختار می‌باشد. شکل (a-۷)، تصویر پیش فرم خام را قبل از عملیات پیرویز نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، نمونه حاوی مقادیر تخلخل‌های ریز و کم در ساختار است که صرفاً ناشی از قرار گرفتن ذرات ریز و درشت مواد اولیه در کنار هم در اثر اعمال فشار پرس می‌باشد. شکل (b-۷) نیز تصویر پیش فرم خام را بعد از



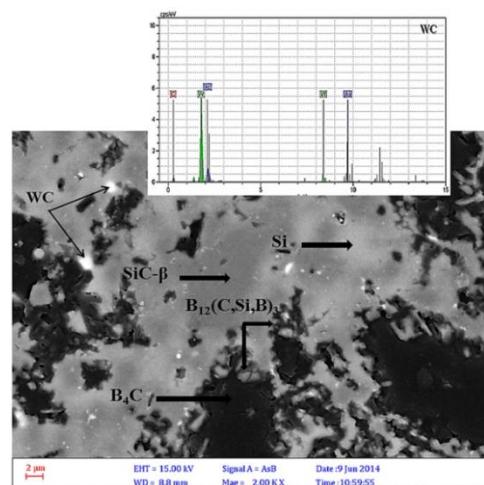
شکل (۹): تصویر ریزساختار علامت‌گذاری شده جهت آنالیز خطی از سرامیک شماره RB-2



شکل (۱۰): نمودارها و پیک‌های مربوط به عناصر تشخوص داده شده در آنالیز خطی از سرامیک شماره RB-2



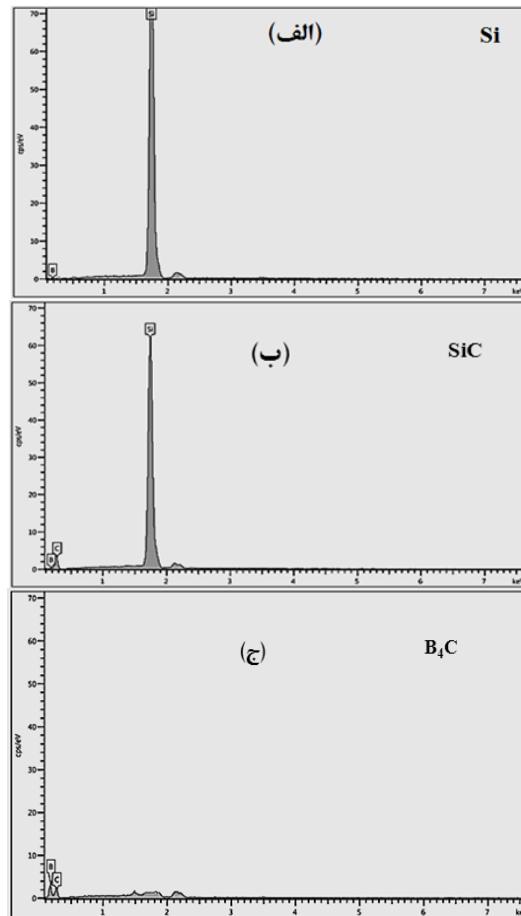
شکل (۷): تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی از پیش فرم کارید بور (a) قبل از پیروزی و (b) بعد از پیروزی



شکل (۸): تصویر SEM گرفته شده از ریزساختار سرامیک RB-2 با بزرگنمایی ۲۰۰۰۰^X

نرم افزار آنالیز تصویری کلمکس تهیه شده است که مقادیر این فازها پس از رخنه دهی در جدول ۲ آورده شده است. مطابق با تصاویر شکل ۱۱، دانه های B_4C با رنگ آبی، ترکیب فازهای $\beta\text{-SiC}$ با رنگ قرمز، Si باقی مانده با رنگ سبز و ناخالصی WC نیز با رنگ بنفش مشخص شده است. همان طور که در جدول ۲ آورده شده است، مقادیر کمی ناخالصی کاربید تنگستن (WC) به همراه فازهای اصلی شناسایی شده است که در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز مشخص هستند. همان طور که قبله گفته شد، این ناخالصی ناشی از گلوله مورد استفاده از جنس WC می باشد که عدم حضور آنها در ترکیب نمونه ها اجتناب ناپذیر است. شکل ۱۲، تأثیر افزودنی کربن اکتیو را بر روی مقادیر فازهای سیلیسیم باقی مانده و فاز $\beta\text{-SiC}$ تشکیل شده نشان می دهد. محور سمت راست و چپ این نمودار به ترتیب مقادیر فاز SiC تشکیل شده و سیلیسیم باقی مانده را نشان می دهد و بر روی محور افقی نیز شماره نمونه ها مشخص شده است. همان طور که در شکل ۱۲ مشاهده می شود، نمونه RB-1 دارای بیشترین مقدار سیلیسیم باقی مانده یعنی٪ ۳۵ است. این بدان معنی است که در این نمونه، مقدار واکنش صورت گرفته بین کربن و سیلیسیم در پایین ترین مقدار خود قرار دارد که این نکته با مقدار فاز $\beta\text{-SiC}$ تشکیل شده که کمتر از بقیه نمونه هاست، مطابقت دارد. درواقع با توجه به اینکه در این نمونه، پودر کربن اکتیو به ترکیب اولیه اضافه نشده بود، افزایش سیلیسیم واکنش نکرده و تشکیل کمتر فاز $\beta\text{-SiC}$ انتظار می رفت. با توجه به شکل ۱۲ و تصاویر آنالیز تصویری شکل ۱۱، با افزایش مقدار افزودنی کربن اکتیو، مقدار سیلیسیم باقی مانده از ٪ ۱۸ به ٪ ۲۱ افزایش یافته است. همان طور که در مورد نمونه RB-1 در بالا گفته شد، سرامیک RB-3 نیز به علت حداکثر واکنش های صورت گرفته بین کربن و سیلیسیم، دارای کمترین مقدار سیلیسیم باقی مانده و بیشترین مقدار $\beta\text{-SiC}$ می باشد.

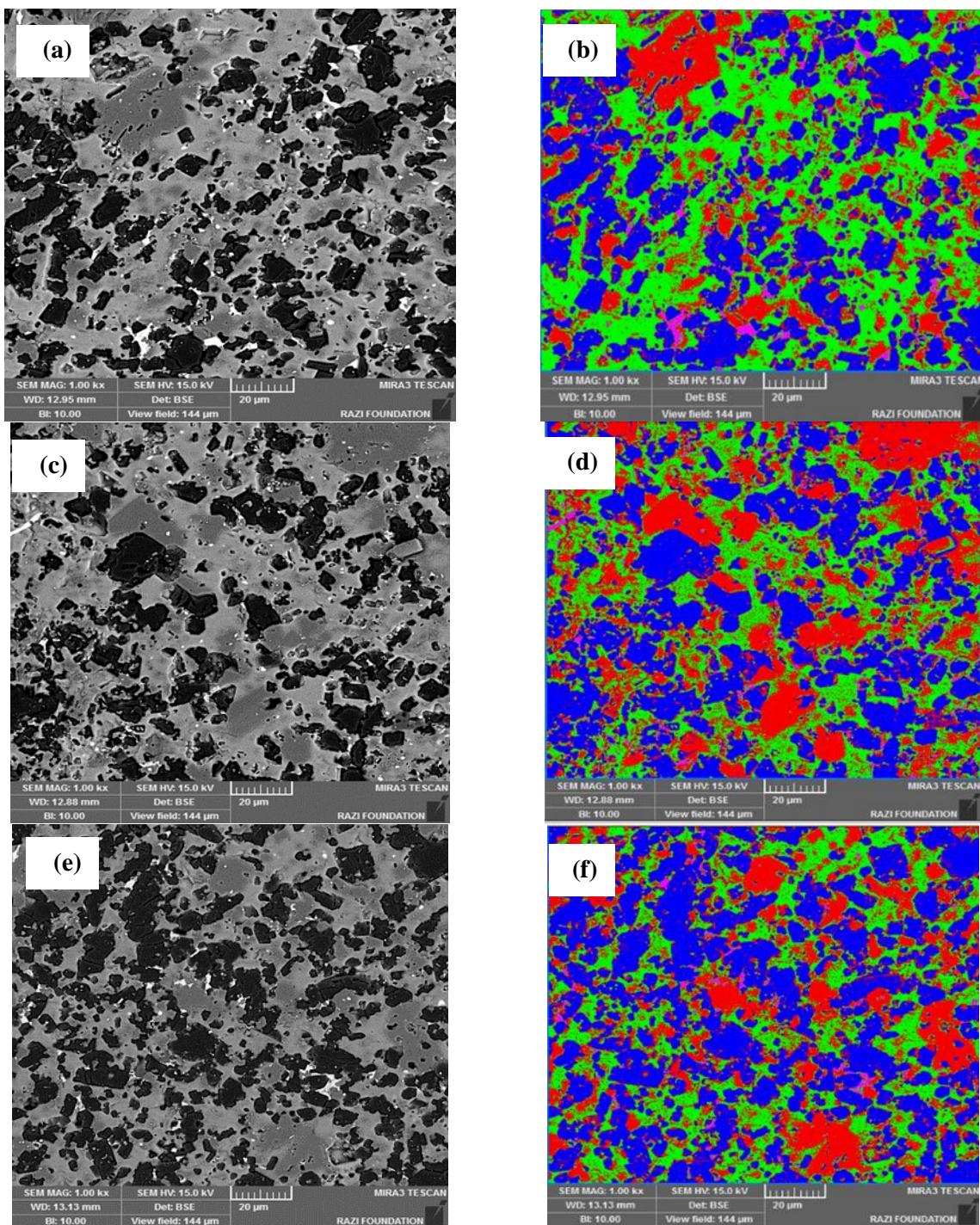
لازم به ذکر است که علاوه بر آنالیز خطی (Line Scan) گرفته شده، اشکال (۱۱-الف) تا (۱۱-ج) نیز آنالیز خطی EDAX نقطه ای فازهای گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی SEM را نشان می دهد. آنالیز نقطه ای فاز ناخالصی تنگستنی کاربید تنگستن (WC) نیز در شکل (۸) آورده شده است.



شکل (۱۱): تصاویر آنالیز نقطه ای گرفته شده از فازهای سرامیک RB-2

۱-۲-۳- درصد فازهای ترکیب سرامیک RBBC

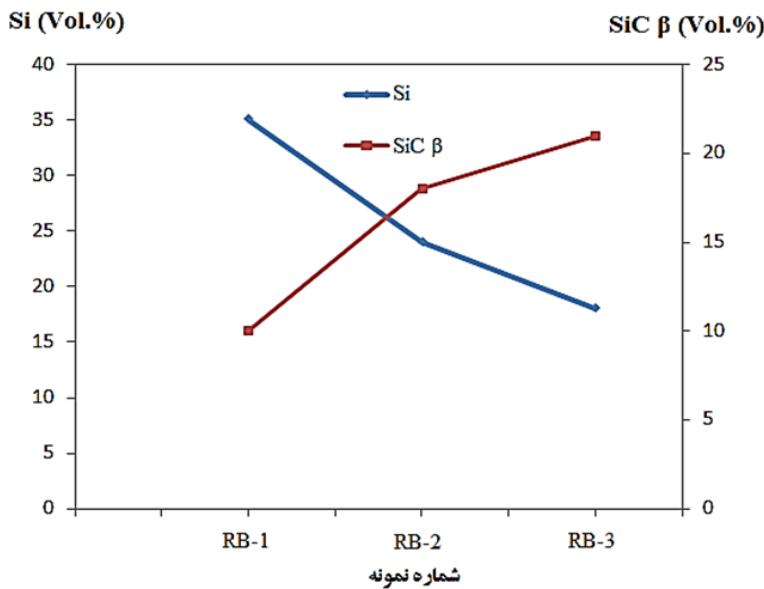
در ادامه، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه آنالیز تصویری نمونه های RB-1، RB-2 و RB-3 که در آنها مقادیر کربن اکتیو و اندازه ذرات کاربیدبور متفاوت است، در شکل ۱۱ با بزرگنمایی × ۱۰۰۰ به نمایش در آمدند. اشکال (a) و (b)، (c) و (d) و (e) و (f) به ترتیب تصاویر مربوط به نمونه های RB-1، RB-2 و RB-3 را نشان می دهند. به منظور بررسی مقادیر فازهای موجود در سرامیک پس از فرآیند فلز خوارانی، تصاویر شبیه سازی نمونه ها توسط



شکل (۱۱): تصاویر مربوط به سرامیک‌های RBBC (a, c, e) و RB-3 (b, d, f) با بزرگنمایی $1000\times$ تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) از سطح پولیش شده نمونه‌های RB-1، RB-2 و RB-3. رنگ آبی، Si: رنگ سبز و ناخالصی WC با رنگ بنفش مشخص شده‌اند.

جدول (۲): درصد فازهای موجود در سرامیک‌های RBBC تولید شده با درصدهای مختلف افزودنی کربن اکتیو.

نمونه	درصد ترکیبات سرامیک‌های (%vol) RBBC			
	Si	$\beta\text{-SiC}$	$\text{B}_{12}(\text{B},\text{C},\text{Si})_3+\text{B}_4\text{C}$	WC
RB-1	۳۵	۱۰	۵۳/۳	۱/۷
RB-2	۲۴	۱۸	۵۵	۳
RB-3	۱۸	۲۱	۵۹	۲



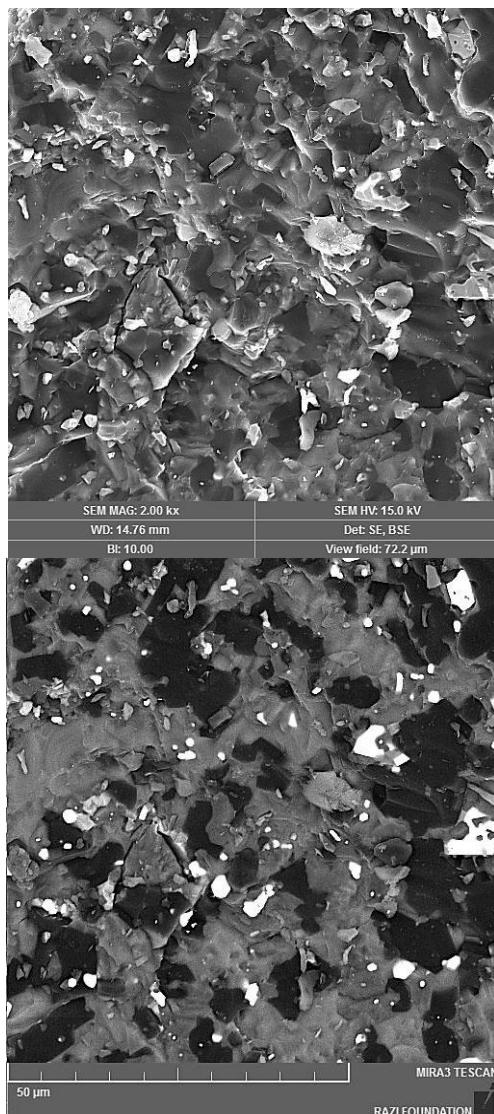
شکل (۱۲): نمودار مربوط تأثیر پارامتر افزودنی کربن اکتیو بر روی مقدار سیلیسیم باقیمانده و کاربید سیلیسیم تشکیل شده پس از فرآیند فلزخوارانی

بیشتر، حفرات پرشده و برخی از آن‌ها نیز با سیلیسیم باقیمانده پر می‌شوند.

۲-۲-۳- بررسی ریزساختار سطح شکست سرامیک RBBC
میکرو گراف‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی برای سطح مقطع شکست در سرامیک‌های RBBC با درصدهای مختلف افزودنی کربن اکتیو، در شکل‌های ۱۴ تا ۱۷ نشان داده شده است. شکست در نمونه‌های کاربیدبور تک فاز، از نوع دروندانه‌ای^۸ می‌باشد به طوری که شکست نمونه با گسیختن و کنده شدن دانه‌ها رخ می‌دهد^[۲۵-۲۶]; اما در سرامیک‌های پیوندی- واکنشی، شکست به صورت مخلوطی از مرزدانه‌ای^۹ و دروندانه‌ای است. این تغییر در مکانیسم شکست، به تشکیل فاز نرم تر $\beta\text{-SiC}$ نسبت به B_4C و حضور فاز بسیار نرم سیلیسیم در زمینه نسبت داده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۴ مشخص شده است، به علت حضور دو فاز

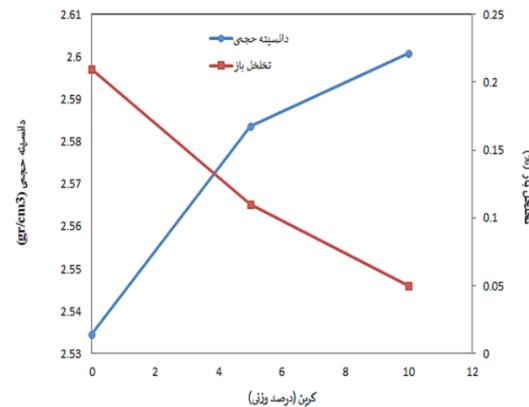
شکل ۱۳، تأثیر افزودنی کربن اکتیو را بر روی مقادیر دانسیته حجمی و تخلخل‌های باز سرامیک RBBC را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این مشخص است، با افزایش درصد وزنی کربن اکتیو، مقدار دانسیته حجمی به طور پیوسته افزایش می‌یابد. بالاترین مقدار دانسیته برای نمونه با ۱۰ درصد وزنی کربن اکتیو، $2/5345 \text{ g.cm}^{-3}$ و کمترین مقدار دانسیته برای نمونه بدون افزودنی کربن اکتیو، $2/6008 \text{ g.cm}^{-3}$ به دست آمده است. درصد تخلخل‌های باز نیز با افزایش درصد افزودنی کربن، کاهش می‌یابد. در واقع با افزایش مقدار افزودنی کربن، طبق معادله (۲)، واکنش بیشتری بین کربن و سیلیسیم انجام شده و فاز کاربید سیلیسیم بیشتری تشکیل می‌شود. از آنجایی که دانسیته کاربید سیلیسیم از سیلیسیم باقیمانده بیشتر است، بنابراین دانسیته نهایی نیز با افزایش کربن، افزایش می‌یابد. لذا با انجام واکنش‌های

استحکام خمثی به صورت پیوسته افزایش یافته است. همان طور که در بخش مربوط به تعیین درصد فازها (بخش ۱-۲-۳) گفته شد، در اینجا نیز افزایش استحکام را می‌توان ناشی از واکنش‌های بین کربن با سیلیسیم و تشکیل فاز β SiC در نظر گرفت که با کمتر شدن سیلیسیم باقی‌مانده در ترکیب سرامیک، استحکام خمثی افزایش پیداکرده است.

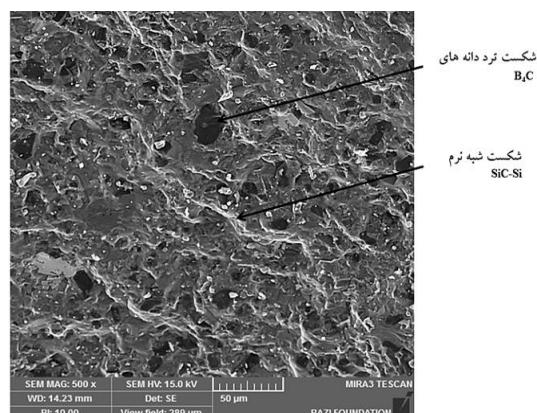


شکل (۱۵): تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) از سطح شکست کامپوزیت RB-1 با بزرگنمایی ۲ Kx BSE تصویر بالا در حالت SE و بایین در حالت گرفته شده است.

SiC و سیلیسیم در زمینه، در این نواحی شکست شبه نرم^{۱۰} وجود دارد که رفتار مشابهی توسط محققین برای نمونه‌های RBBC گزارش شده است [۷].



شکل (۱۳): نمودار مربوط به تأثیر افزودنی کربن اکتیو بر روی مقادیر دانسیته حجمی و تخلخل‌های باز سرامیک RBBC



شکل (۱۴): تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) از سطح شکست کامپوزیت RB-2 با بزرگنمایی x 500

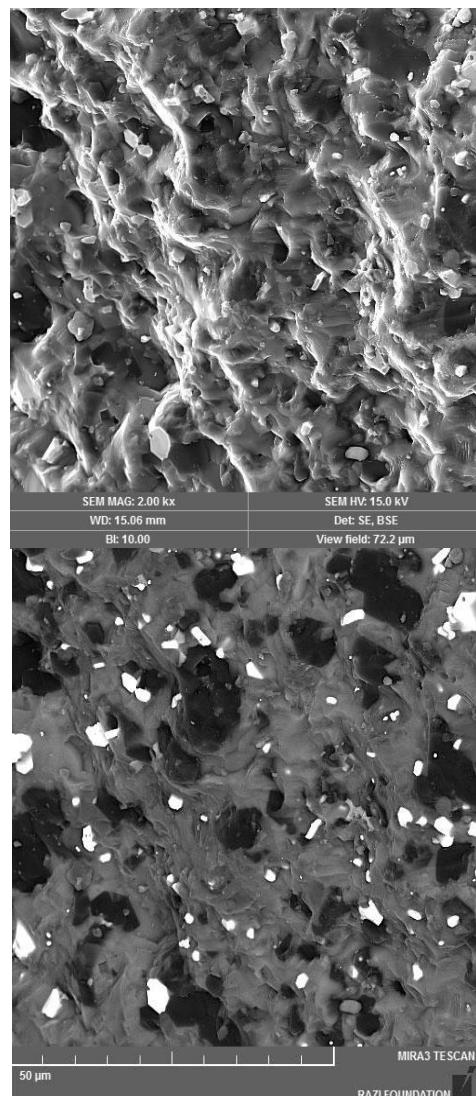
شکل ۱۵، تصویر میکروگراف در حالت‌های SE و BSE از سطح مقطع شکست سرامیک فلزخوارانی شده در دمای ۱۶۰۰°C بدون افزودنی کربن اکتیو و شکل ۱۶ نیز سطح مقطع شکست سرامیک فلزخوارانی شده با ۱۰٪ وزنی کربن را نشان می‌دهد. همان‌طور که از شکل‌ها استبطان می‌شود، با افزایش کربن اکتیو، درصد مناطق شکست شبه نرم در نمونه‌ها بیشتر شده است. شکل ۱۷ نیز نتایج مربوط به مقادیر استحکام خمثی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، با افزودن کربن اکتیو، مقدار

۴- نتیجه‌گیری

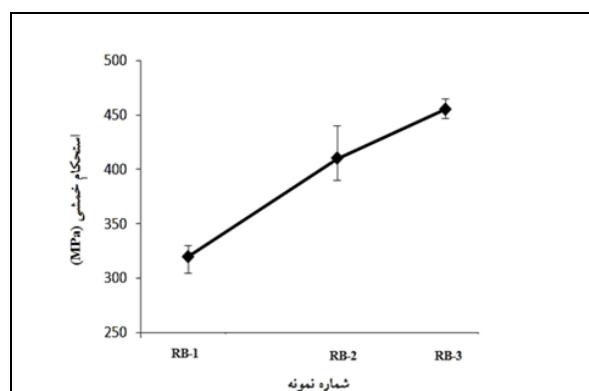
- ۱- آنالیز فازی با استفاده از پراش اشعه X، حضور فازهای β -SiC، B_4C ، $B_{12}(C,Si,B)_3$ و Si در ترکیب‌ها را نشان می‌دهد.
- ۲- آنالیز ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، تشکیل فاز β -SiC به شکل ابر مانند در زمینه سیلیسیمی و همچنین تشکیل کاربیدبور انتقالی $(B_{12}(C,Si,B)_3)$ را اطراف دانه‌های B_4C نشان می‌دهد.
- ۳- با افزایش مقدار افزودنی کربن اکتیو، مقدار سیلیسیم باقی‌مانده از ۱۸٪ به ۲۵٪ کاهش و فاز β -SiC از ۱۰٪ به ۲۱٪ افزایش یافته است.
- ۴- شکست در نمونه‌های B_4C تک فاز، از نوع درون‌دانه‌ای می‌باشد، اما در سرامیک‌های RBBC حاوی افزودنی کربن اکتیو، مکانیسم شکست به صورت ترکیبی از مرزدانه‌ای و درون‌دانه‌ای است.
- ۵- با افزایش کربن اکتیو، به علت تشکیل بیشتر کاربید سیلیسیم، درصد مناطق شکست شبه‌نرم در نمونه‌ها بیشتر شده است.
- ۶- با افزایش مقدار افزودنی کربن اکتیو، مقادیر استحکام خمی روند افزایشی داشته است.
- ۷- با افزایش مقدار افزودنی کربن اکتیو، مقدار دانسیته حجمی سرامیک RBBC افزایش یافته و از سوی دیگر مقدار درصد تخلخل‌های باز آن‌ها کاهش یافته است.

۵- مراجع

- [1] F. Thevenot, "A review on boron carbide. Key Engineering Materials", Vol. 56, pp. 59-88. 1991.
- [2] م. خادمیان، م. سعیدی حیدری، ع. علیزاده و ح. بهاروندی، "بررسی تأثیر دما و زمان باربریزی بر خواص و ریزساختار نانو کامپوزیت آلومینیوم-کاربید بور به روش ریخته گردنی گردابی". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، ۱۳۹۴.
- [3] L. Levin, N. Frage & M. Dariel, "The effect of Ti and TiO₂ additions on the pressureless sintering of B₄C". Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 30, No. 12, pp. 3201-3210. 1999.



شکل (۱۶): تصویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) از سطح شکست کامپوزیت ۳-RB با بزرگنمایی ۲ Kx. تصویر بالا در حالت SE و پایین در حالت BSE گرفته شده است.



شکل (۱۷): نمودار مربوط تأثیر پارامتر افزودنی کربن اکتیو بر روی مقادیر استحکام خمی.

- [15] A. Mortensen, "Interfacial phenomena in the solidification processing of metal matrix composites". *Materials Science and Engineering: A*, Vol. 135, pp. 1-11. 1991.
- [16] S. Ren & et al, "Effect of calcination process on the properties and microstructure of SiC preform and corresponding SiCp/Al composites synthesis by pressureless infiltration". *Materials Science and Engineering: A*, Vol. 444, No. 1, pp. 112-119. 2007.
- [17] S. Aroati & et al, "Preparation of reaction bonded silicon carbide (RBSC) using boron carbide as an alternative source of carbon". *Journal of the European Ceramic Society*. Vol. 31, No. 5, pp. 841-845. 2011.
- [18] س. ف. رهنماei، ا. ع. نوربخش، ف. کاظمی و م. جعفری، "تأثیر افزودن آلومینیوم بر ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی دیرگدازهای آندالوزیت-کربن-سیلیکون کاربید"، *فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد*، ۱۳۹۲.
- [19] Z. F. Chen, Y. Su, & Y. B. Cheng, "Formation and Sintering Mechanisms of Reaction Bonded Silicon Carbide-[19] Boron Carbide Composites". *Key Engineering Materials*, Vol. 352, pp. 207-212. 2007.
- [20] R. Olesinski & G." Abbaschian, The C- Si (Carbon-Silicon) system". *Journal of Phase Equilibria*, Vol. 5, No. 5, pp. 486-489. 1984.
- [21] K. A. Trick & T. E. Saliba, "Mechanisms of the pyrolysis of phenolic resin in a carbon/phenolic composite". *Carbon*, Vol. 33, No. 11, pp. 1509-1515. 1995.
- [22] C. Zhang & et al. "The Role of Infiltration Temperature in the Reaction Bonding of Boron Carbide by Silicon Infiltration". *Journal of the American Ceramic Society*, 2014.
- [23] S. Hayun & et al, "Rim region growth and its composition in reaction bonded boron carbide composites with core-rim structure". In *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing. 2009.
- [24] D. Mallick & et al, "Development of multi-phase B-Si-C ceramic composite by reaction sintering". *Ceramics International*, Vol. 35, No. 4, pp. 1667-1669. 2009.
- [4] F. Thévenot, "Boron carbide—a comprehensive review". *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 6, No. 4, pp. 205-225. 1990.
- [5] S. Singhal & B. Singh, "Sintering of boron carbide under high pressures and temperatures". *Indian Journal of Engineering And Materials Sciences*, Vol. 13, No. 2, pp. 129. 2006.
- [6] I. G. Talmy & J. A. Zaykoski, "Boron carbide/silicon carbide ceramics". Google Patents. 2000.
- [7] H. Y. Jin & et al. "A Study on Reaction Bonded Ceramics Fabricated by Silicon Infiltration to B4C Preforms". In *Materials Science Forum*. Trans Tech Publ. 2012.
- [8] F. H. Gern & R. Kochendörfer, "Liquid silicon infiltration: description of infiltration dynamics and silicon carbide formation". *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, Vol. 28, No. 4, pp. 355-364. 1997.
- [9] J. Wannasin & M. C. "Flemings, Metal Matrix Composites: Infiltration". Wiley Encyclopedia of Composites.
- [10] S. Hayun & et al, "Static and dynamic mechanical properties of infiltrated B 4 C-Si composites". *Materials Science and Engineering: A*, Vol. 487, No. 1, pp. 405-409. 2008.
- [11] P. Chhillar & et al, "The Effect of Si Content on the Properties of B4C-SiC-Si Composites. Advances in Ceramic Armor III: Ceramic and Engineering Science Proceedings", Vol. 28, No. 5, pp. 161-167. 2007.
- [12] S. Hayun & et al, "The effect of aluminum on the microstructure and phase composition of boron carbide infiltrated with silicon". *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 118, No. 2, pp. 490-495. 2009.
- [13] A. Grytsiv & P. Rogl, "Aluminium–Boron–Carbon, in Refractory metal systems". Springer. pp. 10-38. 2009.
- [14] R. Arsenault & C. Pande, "Interfaces in metal matrix composites. *Scripta Metallurgica*", Vol. 18 No. 10, pp. 1131-1134 1984.

۶- پی نوشت

- [1] Boron Carbide (B₄C)
- [2] Reaction Bonded (RB)
- [3] Hayun et al
- [4] Chhilar et al
- [5] Clemex
- [6] Particle Size Analyzer
- [7] Cloud-like SiC
- [8] Transgranular
- [9] Intergranular
- [10] Semi-Ductile Fracture

[25] R. W. Hertzberg, R. P. Vinci & J. L. "Hertzberg, Deformation and fracture mechanics of engineering materials". Vol. 89. Wiley New York. 1996.

[26] W. D. Callister & D. G. Rethwisch, "Materials science and engineering": An introduction. Vol. 7. Wiley New York. 2007.

Effect of Activated Carbon Additive on Microstructure and Phase Composition of Reaction Bonded Boron Carbide Ceramics

Ahmad bayat^{1,*}, Omid Mirzaee², Hamidreza Baharvandi³

1. M.Sc. Faculty of Materials Engineering and Metallurgy, Semnan University, Semnan, Iran

2 Ph.D. Faculty of Materials Engineering and Metallurgy, Semnan University, Semnan, Iran

3 Ph.D. Composite Center, MUT, Tehran, Iran

*Corresponding author: ahmad.bayat@students.semnan.ac.ir

Abstract

Boron carbide is highly regarded because of many properties such as high hardness, high Young's modulus, low density and etc. However, application of B₄C is rather limited due to difficulties in densification and low fracture toughness. In this research, uniaxial press at constant pressure of 140 MPa was applied to fabrication of boron carbide porous preforms. B₄C powder with size of 43.27 µm, activated carbon with the amount of 5,10,15 Wt.% and phenolic resin powder as a binder and porosity-causing agent with the amount of 9 Wt.%, were used as raw materials. Infiltration operation with molten silicon had performed in vacuum furnace in temperature 1600 °C. β-SiC phase produced from silicon and carbon that caused the strength properties of specimens during infiltration process. Residual silicon was decreased from 35%.vol to 18 vol.% with increasing activated carbon contents, on the contrary, secondary silicon carbide had increasing continuously from 10%.vol to 2 vol.%. Decreasing in residual silicon and increasing in β-SiC phase determined by Image analysis software.

Keywords: Boron Carbide Porous Preform, Activated Carbon Additive, Infiltration, RBBC.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Ahmad Bayat, Omid Mirzaee, Hamidreza Baharvandi, Effect of Activated Carbon Additive on Microstructure and Phase Composition of Reaction Bonded Boron Carbide Ceramics, New Process in Material Engineering, 2020, 14(2), 13-26.